

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT

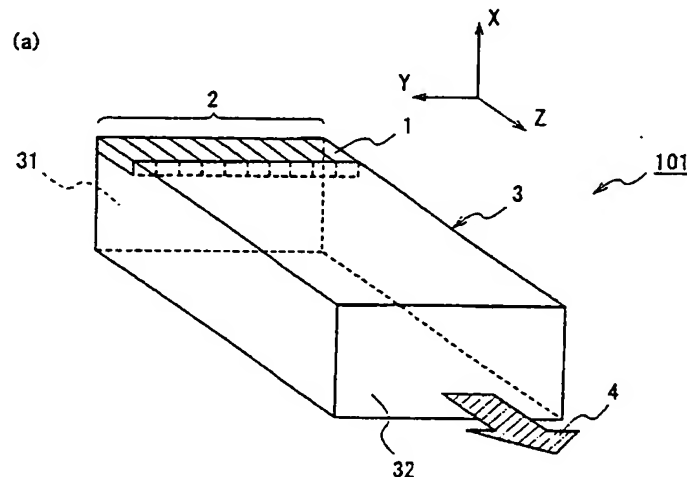
(10) 国際公開番号
WO 2005/057743 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01S 5/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/01S360
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 9 日 (09.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-411441
2003 年 12 月 10 日 (10.12.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 杉田 知也 (SUGITA, Tomoya). 水内 公典 (MIZUUCHI, Kiminori). 笠澄 研一 (KASAZUMI, Ken'ichi). 森川 顕洋 (MORIKAWA, Akihiro). 山本 和久 (YAMAMOTO, Kazuhisa).
- (74) 代理人: 早瀬 憲一 (HAYASE, Kenichi); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 4 番 3 0 号 ニッセイ新大阪ビル 1 3 階 早瀬特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

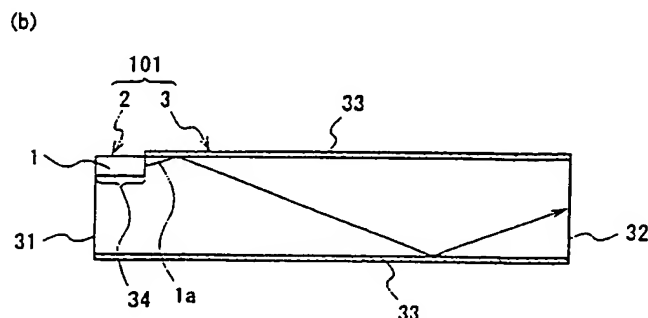
(54) Title: LASER LIGHT SOURCE AND TWO DIMENSIONAL IMAGE FORMING DEVICE

(54) 発明の名称: レーザ光源、及び 2 次元画像形成装置



(57) Abstract: A laser light source (10) has semiconductor lasers (1) and a waveguide tube (3) for propagating emission light from each of the semiconductor lasers (1). The semiconductor lasers are arranged on the upper end on the incident surface (31) side of the waveguide tube such that the emission light (4) from each of the semiconductor lasers enters into the waveguide tube from one end surface (31) of the waveguide tube and exits from the other end surface (32) of the waveguide tube. The structure can realize a small-sized laser light source having high output and capable of outputting emission light having uniform emission light intensity distribution.

(57) 要約: 本発明のレーザ光源 (10) は、複数の半導体レーザ (1) と、該複数の各半導体レーザ (1) からの出射光を伝搬する導波管 (3) とを備え、前記複数の各半導体レーザからの出射光 (4) が、前記導波管の一つの端面 (31) から前記導波管内に入射され、前記導波管の他の端面 (32) から出射されるよう、該複数の半導体レーザが前記導波管の入射面 31 側上端に配置されているものである。これにより、高出力で、且つ均一な出射光強度分布を有する出射光を出力可能な小型のレーザ光源を実現することができる。



WO 2005/057743 A1



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

(S4) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。